

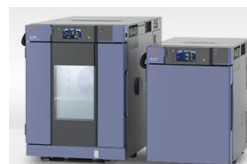
■ 動特性試験環境

対象デバイス	トランジスタ、MOSFET、IGBT、ダイオード
カーブトレーサ	岩通計測社 CS-3200
印加範囲	最大電圧3kV 最大電流400A
測定環境	-40℃~150℃

<カーブトレーサ>



<恒温槽>



■ 試験結果例

	V(BR)CES [V]	Vce sat [V]	VF [V]	VGE(th) [V]
Tvj = 25℃	VGE = 0V IC = 0.20mA	VGE = 15.0V IC = 50A	VGE = 0V IF = 50A	IC = 0.50mA VCE = VGE
No.1	719	1.63	1.41	3.85
No.2	726	1.59	1.42	3.85
No.3	744	1.61	1.45	3.90
No.4	719	1.62	1.44	3.85
No.5	742	1.60	1.45	3.95